EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

10194769

PUBLICATION DATE

28-07-98

APPLICATION DATE

16-01-97

APPLICATION NUMBER

09005673

APPLICANT: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD;

INVENTOR: DANZUKA TOSHIO;

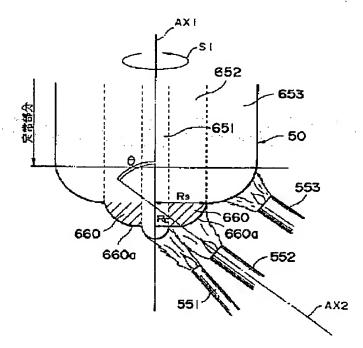
INT.CL.

: C03B 37/018 C03B 37/012 C03B

37/014 G02B 6/00

TITLE

PRODUCTION OF OPTICAL FIBER



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a producing method of optical fiber provided with such a structure as to effectively restrain any influences due to a non-linear optical effect with increased MFD and downsize the diameter of the inside core of the optical fiber.

> SOLUTION: This method is to make an interference between a flame from the second burner 552 for forming the second porous glass 652 bound to become the outside core and another flame from the first burner 551 for forming the first porous glass 651 bound to become the inside core, and to dispose the second burner 552 in a specific position so as to enable downsizing the diameter of the first porous glass 651 viz. the inside core of the resulting optical fiber.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出慮公開母号

特開平10-194769

(43)公開日 平成10年(1998) 7月28日

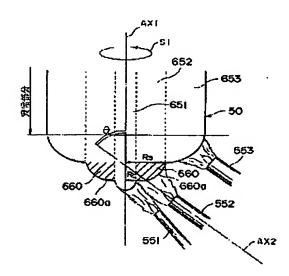
(51) Int.CL		意则配号	ΡI					
COSB	37/018		C03B 3	7/018	/018 A			
	37/012		3	7/012		Z		
	37/014		3	7/014		Z.		
G 0 2 B	8/00	356		8/00	3 5 6 A			
0025	0,00		••	-,				
			松陆直部	末韶球	苗泉項の数6	OL	(全 9 円)	
(21) 山蘇番号		物顧平9−5673	(71) 出項人	(71) 出碩人 000002130				
				住友包	员工業株式会社			
(22)出職日		平成9年(1997)1月16日	大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5 433号				15 套33号	
			(72) 宠明者 擬山 佳生					
				神奈川	具横浜市桑区田	谷町1岩	3地 住友電	
				気工業	床式会社横浜製	作所内		
			(72) 発明者	指野 i	拿			
				神奈川	具横灰市朵区田	谷町1者	建 金灰電	
				気工衆	快式会社投灰製	作所内		
			(72) 発明者	332 家	砂罐			
					具横浜市衆区田 :	2年11年	部 件友组	
			0 %-,		经试销社会 无款			
			(74)代理人		長谷川 芳樹		3名)	
						,,,		
			ı					

(54) 【発明の名称】 光ファイバの製造方法

(57)【要约】

【課題】 MF Dを大きくし、非線形光学効果による影響を効果的に抑える構造を備えた光ファイバを得るとともに、該光ファイバにおける内側コアの細径化を実現するための光ファイバの製造方法を提供する。

【解決手段】 外側コアとなるべき第2多孔質ガラス体652を形成するための第2パーナー552からの火炎と、内側コアとなるべき第1多孔質ガラス体651を形成するための第1パーナー551からの火炎とを干渉させ、第1多孔質ガラス体651、すなわち得られる光ファイバの内側コアの細径化を可能にするよう、第2パーナー552を特定位置に設置する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも、所定の屈折率n,を有する 第1コアと、該第1コアの外国に設けられかつ屈折率n 、(< n.)を有する第2コアと、該第2コアの外層に設 けられかつ屈折率 n. (くn.) を有するクラッドとを備 えた。石英ガラスを主成分とする光ファイバの製造方法 であって、

前記第1コアとなるべき第1多孔質ガラス体を形成する ための第1パーナーと、前記第2コアとなるべき第2多 ための第2パーナーと、前記クラッドとなるべき第3多 孔質ガラス体を設算2多孔質ガラス体の外層に形成する ための第3パーナーとを、それぞれ所定の位置に設置

前記第1~第3パーナーからの火炎中でそれぞれ合成さ れたガラス微粒子を回転している出発符の先端部分に堆 **請させることで、該出発管の先端から該出発棒の長季方** 向に沿って成長した、前記第1~第3多孔質ガラス体か らなる多孔質母村を得る第1工程を備え、

前記第2パーナーは、前記第1多孔質ガラス体の最大外 20 径を2Rc、前記第2多孔質ガラス体の最大外径を2R sとするとき、その中心軸が、

0. 3×(Rs-Rc)+Rc以上、かつ0.5×(R s-Rc)+Rc以下で定義される。前記第2多孔質ガ ラス体表面のガラス微粒子維備領域と交差するよう設置 されることを特徴とする光ファイバの製造方法。

【請求項2】 前記第2パーナーは、その中心軸が前記 出発物の回転軸に対し、50°~70°傾くよう設置さ れることを特徴とする請求項1記載の光ファイバの製造

【論求項3】 前記第3パーナーに、少なくともフッ素 系ガスを供給することを特徴とする語求項1又は2記載 の光ファイバの製造方法。

【請求項4】 前記第3パーナーに供給されるフッ素系 ガスの供給量は、得られる光ファイバのクラッドの、純 石英に対する比屈折率差がり、03%~0、1%となる よう調節されることを特徴とする請求項3記載の光ファ イバの製造方法。

【請求項5】 前記第1工程は、さらに、得られた多孔 賃母付を挽結して中間ガラス母材を得る工程を含むこと 40 を特徴とする語求項1~5のいずれか一項記載の光ファ イバの製造方法。

【論求項6】 前記第1工程で得られた中間ガラス母材 を所定の外径に延伸した後、気相合成法により該延伸さ れた中間ガラス母材の外周に、前記クラッドの外周を覆 うジャケット部となるべき第4多孔質ガラス体を形成し て複合母材を得、そして、

前記複合母材を規結して光ファイバ母材を得る第2工程 を構えたことを特徴とする語求項5記載の光ファイバの 製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の届する技術分野】との発明は、長距離大容量光 **通信システムに適用可能な光ファイバであって、特に、** 波長分割多盆(WDM)通信方式に好酒でかつその容分 散波長が所望節囲凝岡内に設定された分散シフトファイ パの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来から、伝送路としてシングルモード 孔質ガラス体を該第1多孔質ガラス体の外周に形成する 10 光ファイバ(以下、SM光ファイバという)が適用され た光通信システムでは、通信用信号光として 1. 3μm 波長帯あるいは 1. 55μm波長帯の光が利用されるこ とが多かった。ただし、最近では、任送路中における伝 送損失低減の額点から1.55μ加波長帯の光の使用が 増しつつある。特に、1.55 mm波長帯の光の任送路 に適用されるSM光ファイバ(以下、1.55μm用S M光ファイバという)は、石英系SM光ファイバの伝送 損失が1.55 μm波長帯の光に対して最小になること から、その波長分散(波長によって光の伝統速度が異な るためパルス波が広がる現象) も1. 55 μ m波長帯の 光に対してゼロになるよう設計されている。このよう に、ゼロ分散波長が1.55μm波長帯付近にシフトレ た1.55μm用SM光ファイバは、一般に分散シフト ファイバと呼ばれる。

> 【0003】従来の分散シフトファイバとしては、例え は特許香号第2533083号公報(第1従来例)に、 その零分散波長が1.55μm付近にシフトされた分散 シフトファイバの断面構造、組成及びその製造方法が関 示されている。 との第1従来例の分散シフトファイバ は、GeO,-SiO,(ゲルマニウムを含むSiO,) からなる内側コアと、SiO」からなる外側コアと、F -SiO、(フッ煮を含むSiO。) からなるクラッドと を構えている。ただし、この第1位来例の分散シフトフ ァイバの屈折率プロファイルは、クラッドに相当する部 分に凹みを持たない、いわゆるMarched 型プロファイル であり、このMatched 型プロファイルを有する光ファイ バをこの明細書ではMarched 型ファイバという。一方、 クラッドに相当する部分に凹みが設けられた屈折率プロ ファイルは、Depressed cladding型プロファイルと含わ れ、特にこの明細書では、このDepressed cladding 型 プロファイルを有する光ファイバをDepressed 型ファイ バという。なお、この第1従来例の分散シフトファイバ の構造では、1.55μm付近の容分散波長の設定のみ が実現可能である。

【0004】また、特関昭63-208005号公銀 (第2従来例) には、コアの外国に該コアよりも低い屈 折率を有する第1クラッドと、該第1クラッドの外国に 該第1クラッドよりも高い屈折率を有する第2クラッド を構えた、Depressed cladding型プロファイルを育する 50 分散シフトファイバが関示されている。この第2従来例

Communication of the second

の分散シフトファイバの目的は、1.3μm~1.5μm
の放長帯の広範囲に渡って液長分散を抑えることにある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】近年、高速かつ大容量の伝送システムの機能が盛んに研究されているが、そのうち、特に、被長分割多重(WDM)方式の伝送システムが注目を集めている。この方式は、互いに波長の異なる複数の信号光を同時に1つの伝送路で伝送する方式であり、伝送可能な情報量を飛躍的に増加させる技術であ 10 る。

【0006】とのような伝送システムを実現するため、伝送路として適用される光ファイバには様々な新しい仕様が要求されており、上述したような従来の分散シフトファイバでは既に対応できない状況となってきている。【0007】特に、従来の分散シフトファイバのモードフィールド径(MFD)は8μπ程度であり、信号光のパワーが大きくなると非線形光学効果による影響が発生しやすくなる。また、伝送システムに適用される各分散シフトファイバ間では波長分散のバラツキが大きいため、信号光波長とそれらの零分散波長とが一致してしまうと、非根形光学効果の一つである四光波提合によるノイズが発生しやすくなるなどの課題があった。

【0008】なお、非線形光学効果とは、光強度の密度等の増大とともに信号光パルスが歪む現象であり、伝送速度の大きな割約要因となる。

【0009】一方、従来のように内側コアと外側コアか ちなるデュアル・コア・シェイプ (Dual Core Shape) 型構造を備えた分散シフトファイバの製造において、内 側コアの外径に対して外側コアの外径を十分に大きくす る場合(例えば、5倍~10倍程度)、必然的に内側コ アの外径に依存して外側コアの外径も大きくせざるを得 ない。特に、この外側コアに屈折率を増加させるために GeO,を添加すると、該外側コアにおける屈折率プロ ファイルの径方向の平坦化が強しくなる。このため、外 側コアにゲルマニウムを添加して屈折率を調整する場 台、内側コアと外側コアの外径比を所望の値に維持した 状態で該外側コアにおける屈折率プロファイルの径方向 の平坦化を実現するためには、内側コアのさらなる細径 化が望まれる。また、この内側コアの観径化は、コア領 40 域(内側コア及び外側コアを含む)の中心領域における 信号パワーの集中を避け、非線形光学効果の影響を効果 的に抑えるためにも重要な技術課題である。

【0010】との発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、MFDを大きくし、非線形光学効果による影響を効果的に抑える構造を備えた光ファイバを得るための製造方法であって、該光ファイバにおける内側コアの細径化を実現するための光ファイバの製造方法を提供することを目的としている。

[0011]

【課題を解決するための手段】この発明に係る光ファイバの製造方法は、MFDが8.6μm以上、好ましくは 9μm以上であり、かつその報分散放長を代表的な信号光放長である1.55μmよりも長波長側あるいは短波長側にシフトさせた分散シフトファイバであって。石英ガラスを主成分とするシングルモード光ファイバを得るための製造方法である。特に、この分散シフトファイバでは、その報分散波長を信号光波長から所定費ずらずことにより、故意に波長分数を発生させ、非線形光学効果の影響を抑えているので、各分散シフトファイバ間での報分散波長のバランキを許容した伝送システムの報繁を可能にしている。

【0012】当該製造方法により得られる光ファイバ1は、例えば図1に示されたように、石英ガラスを主成分とし、かつ所定の屈折率n。を有する第1コア10(内側コア)と、該内側コア10の外周に設けられかつ屈折率n。(くn。)を有する第2コア20(外側コア)と、該外側コア20の外周に設けられかつ屈折率n。(くn。)を有するクラッド30と、該クラッド30の外周に設けられたジャケット部40とを備えている。なお、このジャッケット部40は、信号光の伝統には実質的に寄与しないガラス領域(該信号光がほとんど伝染しないガラス領域)であって、主に内側コア10、外側コア20、及びクラッド30を物理的に結論するために設けられている。このため、該ジャケット部40を物理クラッドということもある。

【0013】以上の構成を備えた光ファイバを得るため、この発明に係る光ファイバの製造方法は、上記内側コア10となるべき第1多孔質ガラス体651と、該第1多孔質ガラス体651と、該第1多孔質ガラス体652と、該第2多孔質ガラス体652と、該第2多孔質ガラス体652とが高います。ド30となるべき第3多孔質ガラス体653とを備えた多孔質母材50(スート・プリフォーム)を得るための第1工程を構える。

【0014】上記第1工程では、例えば図2及び図3に示されたように、回転する出発棒501の先端から該出発掉501の長手方向に沿って上記第1~第3多孔質ガラス体651~653を構成するためのガラス微粒子がそれぞれ堆積することにより、上記多孔質母材50が該出発符501の長手方向に沿って成長する。なお、この第1工程では、各多孔質ガラス体651~653を構成するためのガラス微粒子をそれぞれ合成するため、第1~第3パーナー551~553が所定位置に設置されている。

【0015】特に、上記第2パーナー552は、第1多 孔質ガラス体651の最大外径を2Rc(出発符501 の回転端AX1に沿ってその外径が一定になっている定 京部分の外径)、前記簿2多孔質ガラス体の最大外径を 502Rs(出発符501の回転端AX1に沿ってその外径 が一定になっている定窩部分の外径)とするとき、その 中心軸AX2が、0、3×(Rs-Rc)+Rc以上、 かつ(). 5×(Rs-Rc)+Rc以下で定義される。 上記第2多孔臂ガラス体652のガラス微粒子堆積領域 660a (第2多孔質ガラス体652における成長領域 660の表面)と交差するよう設置される。なお、成長 領域とは、各多孔質ガラス体において、ガラス隊餃子が その表面に堆積することで該多孔質ガラス体自体の外径 が時間経過とともに変化している領域である。また、ガ ラス微粒子堆積領域とは、該成長領域の表面である。 【0016】以上のように、外側コア20となるべき第 2多孔質ガラス体652を形成するための第2パーナー 552を上述の特定位置に設置することにより、内側コ ア10となるべき第1多孔質ガラス体651を形成する ための第1パーナー551からの火炎と、該第2パーナ -552からの火炎とを干渉させ、第1多孔質ガラス体 651、すなわち内側コア10の細径化を可能にしてい る。 加えて、内側コア10の細径化により外側コア20 の外径も小さくすることが可能となり(内側コア10と 外側コア20の外径比は一定)、ゲルマニウムが該外側 20 コア20に添加された場合であっても、該外側コア20 の径方向の屈折率プロファイルの平坦化を実現すること ができる。また、この内側コア10の網径化により、コ ア領域 (内側コア10及び外側コア20を含む) の中心 領域における信号パワーの集中を避け、非線形光学効果 の影響を効果的に抑えることもできる。

【0017】加えて、この発明に係る光ファイバの製造 方法では、成長中の多孔賢母材50へのガラス微粒子の 堆積効率の観点から、上記第2パーナー552は、その 中心軸AX2が出発棒501の回転軸AX1(成長中の 30 多孔貿母材50の回転輪) に対し、所定角度 (50) ~70~)傾くよう設置されている。

【0018】また、上述の第1工程において、クラッド 30となるべき第3多孔質ガラス体653を形成するた めの第3パーナー553には、該クラッド30の屈折率 を調整するために、少なくともファ素系ガスが供給され ており、特に、該第3パーナー553に供給されるファ 素系ガスの供給量は、当該製造方法により得られる光フ ァイバ1のクラッド30の、純石英に対する比屈折率差 が0.03%~0.1%となるよう調節されている。 【0019】また、この発明に係る光ファイバの製造方 法において、第1工程は、さらに、得られた多孔貿母材 50を焼枯して中間ガラス母材51を得る工程を備えて いる (図5 変麗)。

【0020】さらに、この発明に係る光ファイバの製造 方法は、上記ジャケット部40を形成するため、図6~ 図8に示されたように、第1工程で得られた中間ガラス 母村51を所定の外径に延伸した後、VAD (Vapor ph ase axial deposition) 注. OVD (Gutside vapor ph ase deposition) 法等の気相台成法により該延伸された 50 め、S + O 、(故意には不純物を含まないガラス領域)

中間ガラス母村51の外周に、上記クラッド30の外園 を覆うジャッケット部40となるべき第4多孔質ガラス 体654を形成して複合母村52を得、そして、 骸複合 母村52を焼結して光ファイバ母村53を得る第2工程 を備えている。

[0021]

【発明の真施の形態】以下、この発明に係る光ファイバ の製造方法を図1~図9を用いて説明する。なお、図中 同一部分には同一符号を付して説明を省略する。

【0022】図1は、当該製造方法により得られる光フ ァイバ(分散シフトファイバ)の断面構造及びその屈折 率プロファイルを示す図である。特に、この光ファイバ 1は、モードフィールド径 (MFD) が8.6 µ m以上 (好ましくは9 µm以上) かつその零分散波長が1.5 5 μ mよりも長波長側あるいは短波長側にシフトされた 分散シフトファイバであって、石英ガラスを主成分とす るシングルモード光ファイバである。

【0023】この図において、光ファイバ1は、コア領 域として、第1の屈折率11を有する、外径4の内側コ ア10と、該内側コア10の外国に設けられかつ第1の 屈折率n,よりも低い第2の屈折率n,を有する外側コア 20を備えている。また、外側コア20 (外径b) に対 する内側コア10 (外径a) の外径比Ra (=a/b) は0.1~0.2である。

【0024】さらに、上記コア領域(内側コア10及び 外側コア20を含む)の外周には、第2の屈折率11、よ りも低い第3の屈折率n,を有する、外径cのクラッド 30が設けられ、さらに、該内側クラッド30の外周 は、第3の屈折率n.よりも高くかつ第2の屈折率n.よ りも低い第4の屈折率n、を有する、外径dのジャケッ ト部40が設けられている。なお、このジャケット部4 ()は、信号光がほとんど伝播しないガラス領域であっ て、主に、上述の内側コア10、外側コア20、及びク ラッド30を物理的に補強するために設けられたガラス 領域であるため、一般に物理クラッドと呼ばれている。 【0025】なお、図1に示された屈折率プロファイル 150の構軸は、光ファイバ1の断面(伝統する信号光 の進行方向に対して垂直な面)における線上上の各位置 に相当している。さらに、この屈折率プロファイル15 0において、領域101は上記内側コア10の領し上の 各部位の屈折率 (n,)、領域102は上記外側コア2 ①の領し上の各部位の屈折率(n,)、領域103は上 記クラッド30の様し上の各部位の屈折率(n,)、領 域104は上記ジャケット部40の線し上の各部位の屈 折率 (m,) に対応している。

【0026】光ファイバ1の基本組成は、内側コア10 がGeO,-SiO, 外側コア20がGeO,-Si Oz、クラッド30がF-SIOzである。また、ジャケ ット部40は、実質的に信号光の伝递に寄与しないた

والمعاأ للسليفينية والمراود فيراور أكافلا فللتعالية الراوادات العارز فالمحرد

. (5)

である。

【0027】ただし、光ファイバ1は、後述するように 内側コア10、外側コア20、及びクラッド30には塩 素が含まれるため、実際の組成は以下のようになる。な お、塩素 (C1) は屈折率を上げる添加物として知られ ており、該C1による屈折率変化は、該C1の造度10 0000面当たり0.01%である。

[0028]

クラッド

: S:O,+GeO,+C1 内側コア

外側コア : S 1 O 2 + G e O 2 + C 1

 $: S : O_1 + F + C 1$

ジャケット部:SIO.

また。この明細書において、各ガラス領域の比屈折率差 △は純石英ガラスを基準にして以下のように定義されて いる。

[0029]

 $\triangle = (n_1^1 - n_2^1) / 2n_2^2 = (n_2 - n_2) / n_2$ ことで、n゚は基準となる純石英ガラスの屈折率、n゚は 各ガラス領域の屈折率を示す。従って、ファ素等が添加 され、その屈折率が絶石英ガラスよりも低下したガラス 20 領域の比屈折率差は負の値として表される。また、この 明細書において各ガラス領域間の比屈折率差は、それぞ れの純石英ガラスに対する比屈折率差の差分(大きい方 の値から小さい方の値を引いた正の値) で以下のように 表される。

【0030】内側コアと外側コアの比屈折率差 0. 7%~0. 8%

外側コアとクラッドの比屈折率差 : 0. 1%~0.

クラッドとジャケット部の比屈折率差:0.03%~

なお、ジャケット部40の、終石英ガラスに対する比屈 折率差は0%である。

【0031】次に、上述の構造を備えた光ファイバ1の 得るための、当該製造方法について、 図2~図9を用い て説明する。

【0032】当該製造方法では、第1工程で内側コア1 O及び外側コア20を含むコア領域と、クラッド30と なるべき多孔貿母材50をVAD (Vapor phase axia) deposition) 注により形成し、得られた該多孔貿母材5 0を触絡して中間ガラス母村51を得る。

【0033】図2は上記VAD法による第1工程の多孔 質母付50の製造を説明するための回であり、図3は図 2に示された第1工程における、パーナー設置位置を設 明するための図である。

【0034】まず、第1工程では、図2に示されたスス 付け装置は、出発棒501の先端部分に該出発管501 の長手方向に沿って伸びた多孔質母付50を製造する。 このスス付け装置は、少なくとも排気口504を備えた

機503を備えている。また、支持保備503には回転 可能な支持棒502が設けられており、この支持額50 2の先端には多孔質母材50を成長させるための出発棒 501が取り付けられている。

【0035】図2のスス付け装置には、さらに内側コア 10となるべき第1多孔質ガラス体651(スス体)を 堆積させるための第1パーナー551と、外側コア20 となるべき第2多孔質ガラス体652 (スス体) を堆積 させるための第2パーナー552と、クラッド30とな 10 るべき第3多孔質ガラス体653(スス体)を堆積させ るための第3パーナー553とが、それぞれ所定位置に 設置されており、ガス供給システム600からは各バー ナー551、552、553に対して所望の原料ガス (例えばGeCl。 SiCl。等)、燃焼ガス(H,及 びOz)、及びArやHe等のキャリアガスが供給され

【0.036】多孔質母材50の製造中、第1パーナー5 51. 第2パーナー552及び第3パーナー553の火 炎中では、ガス供給システム600から供給された原料 ガスの加水分解反応によりガラス微粒子が生成され、こ れらガラス微粒子が出発符501の先端部分に準積して いく。この間、支持機構503は、その先端に設けられ た支持棒502を矢印S1で示された方向に回転させな がら矢印S2で示された方向(多孔貿母材50の長手方 向及び出発棒501の長手方向は、それぞれS2の方向 と一致している)に沿って引き上げる時作を行ってい る。この動作により、多孔質ガラス体が出発棒501か ち下方(該出発替501の長手方向)に向かって成長し ていき、該出発符501の長手方向に沿ってその中央部 分に内側コア10となるべき第1多孔質ガラス体651 が、該中央部分を取り聞む周辺領域に外側コア20とな るべき第2多孔質ガラス体652が、そして該第2多孔 賃ガラス体652の外園を取り囲む周辺領域にクラッド となるべき第3多孔質ガラス体653が、それぞれ成長 し、多孔質母付50(スート・プリフォーム)が得られ る。なね、成長中の多孔貿母材50は出発棒501によ り直接保持されているので、該出発符501の回転とと もに回転輪AXlを中心に回転している。

【0037】また、上記第2パーナー552は、第1多 孔質ガラス体651の最大外径を2Rc(出発符501 の回転離AX1に沿ってその外径が一定になっている定 常部分の外径) . 前記第2多孔質ガラス体の最大外径を 2Rs (出発符501の回転輪AX1に沿ってその外径 が一定になっている定倉部分の外径)とするとき、その 中心軸AX2が、0.3×(Rs-Rc)+Rc以上、 かつ(). 5×(Rs-Rc)+Rc以下で定義される、 上記第2多孔智ガラス体652のガラス微粒子維積領域 66)a(第2多孔質ガラス体652における成長領域 66()の表面) と交差するよう設置されている(図3巻 容器500と、多孔貫母村50を支持するための支持機 59 照)。加えて、成長中の多孔貫母村50へのガラス像粒

10

子の堆積効率の観点から、上記算2パーナー552は、その中心輸AX2が、出発符501の回転輸AX1(成長中の多孔質母村50の回転輸)に対し、所定角度 (50~~70) 領くよう設置されている。とこで、成長領域(特に、第2多孔質ガラス体652の成長領域660は国中の斜線部分である)とは、各多孔質ガラス体において、ガラス降粒子がその表面に堆積することで該多孔質ガラス体自体の外径が時間経過とともに変化している領域である。また、ガラス降粒子堆積領域とは、該成長領域の表面である。

【0038】以上のように、外側コア20となるべき第 2多孔質ガラス体652を形成するための第2パーナー 552を上述の特定位置に設置することにより、内側コ ア10となるべき第1多孔質ガラス体651を形成する ための第1パーナー551からの火炎と、該第2パーナ ー552からの火炎とを干渉させ、第1多孔質ガラス体 651、すなわち得られる光ファイバ1の内側コア10 の碉堡化を可能にしている。加えて、内側コア10の細 径化により外側コア20の外径も小さくすることが可能 となり(内側コア10と外側コア20の外径比Raはー 25 定) ゲルマニウムが該外側コア20に添加された場合 であっても、該外側コア20の径方向の屈折率プロファ イルの径方向の平坦化を実現することができる。また、 この内側コア10の細径化により、コア領域(内側コア 10及び外側コア20を含む〉の中心領域における信号 パワーの集中を選け、非線形光学効果の影響を効果的に 抑えることができる。

【0039】なお、この第1工程において、クラッド30となるべき第3多孔質ガラス体653を形成するための第3パーナー553には、該クラッド30の屈折率を調整するために、少なくともファ蒸系ガス(具体的にはCF、)が供給されており、特に、該第3パーナー553に供給されるファ深系ガスの供給量は、当該製造方法により得ちれる光ファイバ1のクラッド30の、純石英に対する比屈折率差が0.03%~0.1%となるよう調節されている。

【0040】続いて、上述のVAD法により得られた多孔質母材50は、図4に示された加熱容器700内に設置され、ハロゲンガスを含む雰囲気中で脱水処理が施される。なお、この加熱容器700には該ハロゲンガスを40供給するための導入口702と緋気口701が設けられている。また、この脱水処理中、支持機構503は多孔質母村50を矢印S3で示された方向に回転させながら、矢印S4で示された方向に沿って移動させるよう動作する(この動作により、多孔質母村50全体が加熱される)。

【0041】脱水処理中の容器内温度は1000℃~1300℃程度であり、好ましくは1100℃~1200℃である。また、この真緒例では濃度20000ppm(2%)の塩素ガス(C1₂)を導入口702から供給

しながら脱水処理を行ったが、塩素ガスの濃度は10000ppm~50000ppm(1%~5%)程度であれば十分にその効果が得られる。

【① 042】脱水処理用ガスとしては、塩素ガスの他SIC1。等のハロゲンガスでも同様の効果が得られる。 特に、SIC1。は塩素の添加量を増加し、外側コア20と内側クラッド30との屈折率差を増加させる手段となり得る。

【0043】なお、第1工程において、第1及び第2パ 10 ーナー551.552のそれぞれにに供給される原料ガ スは、得られる光ファイバの外側コア20 (外径b) に 対する内側コア 1 () (外径 a) の外径比R a (= a/ b) が、0.1~0.2となるよう調節されている。 【0044】以上の処理を経て得られた多孔質母村50 は、引続き上述された加熱容器700内で焼結される。 すなわち、図5には図4に示された加熱容器の主要部分 のみが示されている。図示のように支持機構503が多 孔質母材50を矢印S5で示された方向に回転させなが 5矢印S6で示された方向に沿って移動させるよう動作 する。この動作により、該多孔質母付50はその先端か ろヒーター750内に送り込まれ(原結時の容器内温度 は1500℃~1650℃、好ましくは1550℃~1 650℃)、透明な中間ガラス母材51が得られる。 【0045】なお、上述した多孔質母科50の製造、脱 水処理、及び結結処理は同一の容器内で行うことも可能 である。

【0046】次に、この発明に係る光ファイバの製造方法における第2工程では、まず上述の第1工程で得られた。 透明な中間ガラス母村51が図6に示された延伸装置により所望の外径(仕上り外径)に延伸される。なお、この中間ガラス母村51は延伸に先立って、その両端に端部処理が届され、さらに取扱を簡単にするための棒61、62が取り付けられている。

【りり47】図6の延伸装置は、矢印S7で示された方向に沿って移動可能な上側チャック63と、矢印S8で示された方向に沿って移動可能な下側チャック64を億えており、これら上側チャック63及び下側チャック64は、駆動モータ65、66により、それぞれS7、S8の方向に沿って動かされる。また、端部処理された中間ガラス母材51は、棒61が上側チャック63に把持されるとともに、棒62が下側チャック64に把持されることにより、図6の延伸装置に取り付けられる。

【0048】上記上側チャック63はS7の方向に沿って移動することにより、中間ガラス母村51をヒータ68(例えば、経型抵抗加熱炉)内に送り込むよう機能する。一方、下側チャック64はS8の方向に沿って移動することにより。ヒータ68内から中間ガラス母村51を引出すよう機能する。ヒータ68内に送り込まれた中間ガラス母村51は部分的に軟化しているので。この延90仲装置では、上側チャック63の移動速度(中間ガラス

母村51をヒータ68内への送り込む遠度)よりも下側 チャック64の移動速度(中間ガラス母材51をヒータ 68内から引出す速度)を大きくし、該中間ガラス母材 5 1 の軟化部分に引っ張り応力を加えることにより、該 中間ガラス母村51を所望の仕上り外径に延伸する。

11

【①①49】なお、制御部67は、外径測定装置69に より加熱されている軟化部分の所定部位の外径を常時モ ニタしており、所望の仕上がり外径が得られるよう駆動 モータ65、66を制御している。

【0050】続いて、この第2工程では、以上の延伸装 10 なお、ここで示された数値は、上述したように、各ガラ 麗により延伸された中間ガラス母材51の外周に、さら にジャケット部40 (物理クラッド) となるべき第4多 孔質ガラス体654を堆積させ、複合母材52を得る。 なお、この複合母材52の製造は、VAD法あるいはO VD法のいずれを適用してもよい。

【0051】すなわち、図7に示されたように、パーナ 900の火炎中では、ガス供給システム600から供給 された原料ガスの加水分解反応によりガラス微粒子が生 成され、これらガラス微粒子が延伸された中間ガラス母 材5 1の外国に堆積していく。この間、該延伸された中 25 間ガラス母材51は矢印S9で示された方向に回転しな がら矢印S10で示された方向に沿って移動している。 この動作により、中間ガラス母材51の外国に第4多孔 質ガラス体654 (スス体) が堆積していき、複合母材 52が得られる。

【0052】次に、この第2工程では、透明な光ファイ パ母村53を得るべく、図8に示されたように、複合母 材52が焼結される。なお、この焼結処理は上述の加熱 容器700内で追続的に行われる。また、支持機構50 3は、彼台母村52を矢印511で示された方向に回転 30 させながら矢印S12で示された方向に沿って移動させ るよう動作する。この動作により、該複合母材52がヒ ータ750内に送り込まれる。

【0053】具体的に、加熱容器700内における復合 母村52の焼結温度(容器内温度)は、1450℃~1 650℃ (好ましくは1500℃~1600℃) であ る.

【0054】以上のように製造された光ファイバ母材も 3は、図9に示されたように、光ファイバ1の内側コア 10となるべき内側コアガラス100と、外側コア20 となるべき外側コアガラス200と、クラッド30とな るべきクラッドガラス300と、そして、ジャケット部 40となるべきガラス領域400を備えている。

【0055】最終工程 (線引工程) では、ヒータ950 により、以上のような構造を備えた光ファイバ母村53 の一端を加熱しながら該光ファイバ母村53を傾引する ことにより、図1に示された外径125μmの光ファイ バーを得る。

【りり56】なお、上述の製造方法により得られた光フ ァイバ1の特性を以下に示す。

【0057】(組成)

内側コア : SiOz+GeOz+Cl 外側コア : S : O . + G e O . + C 1

クラッド : S : O, + F + C 1

ジャケット部:SIO,

〈屈折率プロファイル〉

外側コアと内側コアとの比屈折率差 : 0. 73% 外側コアとクラッドとの比屈折率差 : 0.18% クラッドとジャケット部との比屈折率差: 0. 08% ス領域における純石英ガラスに対する比屈折率差の差分 (大きい値の方から小さい値の方を引いた正の値)であ

【0058】最終的に、得られた光ファイバ1のMFD は8.6μm.2mの基準長でのカットオフ波長は1. 70 µm、秦分散波長は1.58 µmであった。

【0059】ここで、1. 65 μ m液長帯の光伝送用に 選択される分散シフトファイバのカットオフ波長として は、通常、2mの基準長 (CC!TT-G. 653によ る測定法)で信号光波長よりも短い1.55μm以下が 選択される。

【りり60】カットオフ波長の一般的な評価の基準であ る2mという短い長さでは、当該分散シフトファイバ は、伝送光の基底モードばかりではなく高次モードも伝 做することになる。しかしながら、この真施例のカット オフ波長は信号光波長 (1.55μm) よりも長いが、 高次モードの光は基底モードの光と比べて分散シフトフ ァイバ中の伝搬における源泉率が高いので、数kmの伝 **徴長であれば益底モードに比べて充分に小さくなる。し** たがって、海底通信ケーブルのように任戦距離が数百か **ら数千kmに及ぶ場合には、高次モードによる問題が生** じるととはない。

[0061]

【発明の効果】以上のようにこの発明によれば、外側コ アとなるべき第2多孔質ガラス体を形成するための第2 パーナーを特定位置に設置し、内側コアとなるべき第1 多孔質ガラス体を形成するための第1パーナーからの火 炎と、該第2パーナーからの火炎とを干渉させることに より、第1多孔質ガラス体、すなわち得られる光ファイ パの内側コアの細径化を可能にするという効果がある。 【0062】加えて、内側コアの細径化により外側コア の外径も小さくすることが可能となり(内側コアと外側 コアの外径比は一定〉、ゲルマニウムが該外側コアに添 加された場合であっても、該外側コアの径方向の屈折率 プロファイルの平坦化が実現できるという効果もある。 さらに、この内側コア10の細径化により、コア領域 (内側コア10及び外側コア20を含む)の中心領域に おける信号パワーの集中を選け、非常形光学効果の影響 を効果的に抑えるという効果もある。

50 【0063】従って、上述の製造方法により、より大き

な所望のMFDを有し、非線形光学効果による影響を効果的に抑える構造を備えた光ファイバが得られる。

13

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明に係る製造方法により得られる光ファイバの新面構造及びその屈折率プロファイルを示す図である。

【図2】この発明に係る光ファイバの製造方法における 第1工程 (VAD法) を説明するための図である。

【図3】図2に示された第1工程における、バーナー設 置位置を説明するための図である。

【図4】この発明に係る光ファイバの製造方法における 第1工程中の、脱水処理を説明するための図である。

【図5】この発明に係る光ファイバの製造方法における 第1工程中の 触絡処理を説明するための図である。

【図6】この発明に係る光ファイバの製造方法における 第2工程中の、延伸処理を説明するための図である。

【図7】この発明に係る光ファイバの製造方法における*

*第2工程中の、複合母材の製造(VAD法又はOVD 法)を説明するための図である。

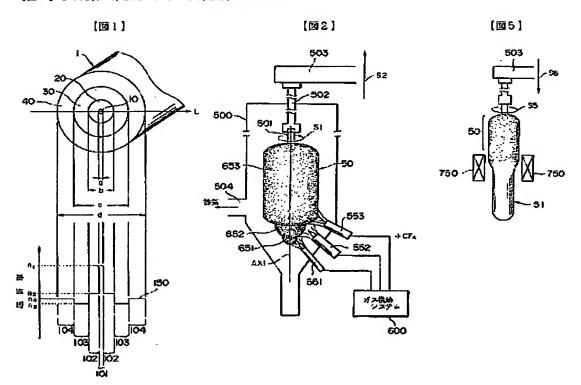
【図8】この発明に係る光ファイバの製造方法における 第2工程中の、穀結処理を説明するための図である。

14

【図9】この発明に係る光ファイバの製造方法における 銀引工程をを説明するための図である。

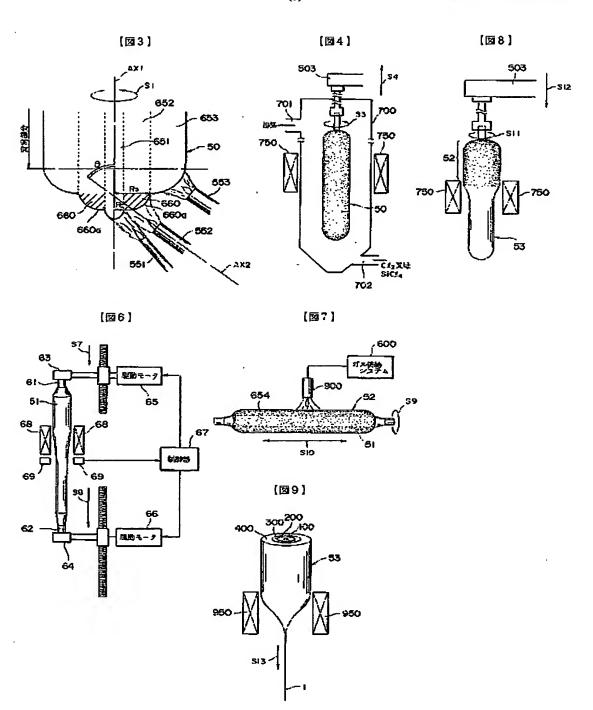
【符号の説明】

1…分散シフトファイバ、10…第1コア (内側コア)、20…第2コア (外側コア)、30…クラッド、40…ジャケット部 (物理クラッド)、50…多孔質母材、51…中間ガラス母村、52…複合母材、63…光ファイバ母材、501…出発棒、551…第1バーナー、552…第2バーナー、553…第3がラス体、653…第3多孔質ガラス体、AX1…成長中の多孔質母材の回転軸、AX2…第2バーナーの中心軸。



(9)

特闘平10-194769



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
☐ BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
FADED TEXT OR DRAWING				
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
OTHER:				

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.